

INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE ALUMINA NAS CARACTE RÍSTICAS ELÉTRICAS DE VARISTORES DE ZNO



S.M. de L.S. Ramos*; E.G. da Costa*; Ana H.A.Bressiani** e R.H.G. Kiminami*** * UFPB-DEE - Campina Grande - PB ** IPEN-CNEN/SP - Caixa Postal 11049 - São Paulo - SP *** UFSCar-DEMa - Caixa Postal 676 - São Carlos - SP



O efeito da adição de alumina (0,005 mol%) nas características elé tricas varistoras dos sistemas 2n0.Bi $_2$ O $_3$.Co $_3$ O e 2n0.Bi $_2$ O $_3$.Co $_3$ O.MnO $_3$ foi analisado em amostras sinterizadas a 1100°C. Para o primeiro sistema ob -Bervou-se a queda nas características elétricas, causada provavelmente peinibição do crescimento dos grãos pelos ions Al³⁺ em excesso. O segundo sistema apresentou uma considerável melhoria no comportamento não ôhmi co, possivelmente pelo aumerto da resistividade nos contornos de grão.

INTRODUÇÃO

Os varistores a base de óxido de zinco (ZnO) são materiais eletro-cerâmicos que apre sentam alta não linearidade na curva tensão corrente (V x I), baixa corrente de fuga e al ta absorção de energia [1]. A absorção de ener gia ocorre essencialmente nos contornos de grãos distribuidos pelo seu volume, conferindo -lhes assim excelentes características elétri cas. Essas características estão diretamente relacionadas com a distribuição dos aditivos , tamanho, ligação e distribuição dos grãos đe óxido de zinco [2,3]. A tensão de trabalho, bem como a tensão de ruptura são grandezas essenci ais na escolha do varistor adequado.Estas gran dezas podem ser avaliadas tanto do ponto de vista macroscópico, através da curva caracte rística V x I, como também do ponto de vista microscópico, através da determinação da tensão por barreira. O valor da tensão por barrei ra (camada intergranular) é convencionalmente calculada com o valor do campo elétrico na den sidade de corrente de 1 mA/cm² [4].

A sensibilidade das características elé tricas varistoras à adição de pequenas quantidades de aditivos tem motivado o desenvolvimen to de multas pesquisas no sentido de determinar os parāmetros microestruturais que maximi zam a performa dos varistores.

O objetivo deste trabalho é avaliar as características elétricas e microestruturais em dos sistemas; ZnO.Bi,O,.Co,O, e ZnO.Bi,O,.Co,O,.MnO, sinterizados a 1100°C, quando da adição de 0.005 mol% de alumina.Para o estudo das fases intergranulares foram reali zadas análises de difratometria de raios-X, mi croscopia eletrônica de varredura e de trans missão.

MATERIAIS E MÉTODOS

Partindô-se de pós de elevada pureza (>99%) as amostras foram preparadas segundo as composições desejadas. Os sistemas estudados foram: ZnO.Bi₂O₃.Co₃O₄ e .ZnO.Bi₂O₃Co₃O₄.MnO₂, com as composições de 3 mol% de Bi₂O₃ e 1 mol% de Co₃O₄, para ambas e de 1 mol% de MnO₂ some<u>n</u> te para o último; a adição de alumina foi de 0.005 mol%. Os pós foram misturados em solução aquosa com ligante orgânico, secos e prensados em forma de discos com 26,5mm de diâmetro e 2,5mm de espessura. Os discos foram sinterizados ao ar, durante 4,5h à 1100°C. Após a sinte rização, as duas faces dos discos foram polidas e metalízadas.

Medidas das características elétricas , tensão versus corrente (campo elétrico x densidade de corrente), foram realizadas utili zando-se uma tensão constante de 10V eficaz e monitoração da temperatura. Através do divisor de potencial capacitivo e da resistência shunt as formas de onda da tensão e da corren te foram observadas.

Difratometria de raios-X foi utilizada para identificação das principais fases existentes. A determinação do tamanho médio dos grãos de ZnO foi realizada pelo método de TGZ e Mini-Mop em micrografias eletrônicas de var redura de amostras polidas e atacadas quimica mente (NaOH, ~1min). Lâminas finas foram obtī das pelo método convencional de desbaste iôni co e observadas em microscópio eletrônico de transmissão com tensão aceleradora de 200 kV.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por difratometria de raios-X foram dete tadas apenas as fases ZnO e 8.Bi₂O₃. A microestrutura típica é apresentada na Figura 1 sendo constituida de grãos de ZnO e fase intergranular β.Bi₂O₃.Os grãos de ZnO possuem distribuição de tamanho homogêneo em toda а extensão da amostra, e os valores obtidos estão apresentados na Tabela 1. 8.Bi,O, é encon trado nos pontos triplos, prolongando-se pe-los contornos de grãos de ZnO, geralmente com espessura reduzida, mas podendo também formar uma fase intergranular de poucos micrometros de espessura. O sistema 3 foi o que apresen tou a fase intergranular melhor distribuida nos contornos de grão, sem localização preferenci almente nos pontos triplos. Em todas as amostras, as fraturas possuem aspecto basicamente intergranular. As técnicas de MET, de defocalização e campo escuro de elétrons espalhados difusivamente, não possibilitaram a observa ção de fase amorfa, permitindo concluir que , se esta existe, possui dimensões bastante re-duzidas (≤ 20 nm) (Figuras 2 e 3).

As características elétricas dos sistemas estudados são apresentados na Tabela 1.0b serva-se que no sistema 2 houve uma queda drás tica no valor do campo de ruptura(Er) e do co eficiente não linear(a), em relação ao sistema 1. A adição de 0.005 mol% de alumina neste caso foi excessiva, atuando como inibidor do crescimento do grão e provavelmente os ions Al³⁺ em excesso aumentam a condutividade nos contornos de grãos: Isso provoca consequentemente a

Sistema	D(µm)	α	Er (v/cm)	(uz) (V/barreira)
1. ZnO.Bi ₂ O ₃ .Co ₃ O ₄	4,8	13,0	1571,50	0,69
2. ZnO.Bi ₂ O ₃ .Co ₃ O ₄ .Al ₂ O ₃	4,5	3,5	265,50	0,12
3. ZnO.Bi ₂ O ₃ .Co ₃ O ₄ .MnO ₂	2,5	8,2	2681,21	-
4. ZnO.Bi ₂ O ₃ .Co ₃ O ₄ .MnO ₂ .Al ₂ O ₃	5,2	16,0	1658,90	1,08

TABELA 1 - Tamanho médio dos grãos de ZnO (\overline{D}), coeficiente não linear (α), campo de ruptura (Er) e tensão por barreira (νz) dos sistemas sinterizados à 1100°C.

queda nas características elétricas [5,6]. No sistema 4 entretanto, a adição de 0.005 mol% de alumina melhorou fortemente o comportamento não ôhmico do varistor. O aumento da resis tividade nos contornos de grão pelas cargas doadoras de elétrons foi certamente fornecido pela alumina absorvida pelo óxido de manganês [7,8]. Diante destes resultados pode se concluir que a adição de 0.005 mol% de alumina tende a favorecer o comportamento não - ôhmico do varistor dependendo do sistema empregado No caso do sistema 4 (ZnO.Bi₂O₃.Co₃O₄.MnO₂Al₂O₃) as características elétricas foram fortemente melhoradas, principalmente pela presença con junta dos óxidos de manganês e de alumina. melhor tensão por barreira calculada foi consequentemente para o sistema 4, de 1,08V/bar-reira (Tabela 1).

A figura 4 mostra o efeito da tensão x corrente, quando do início do processo de rup tura, medido no sistema 1. Neste caso a corrente que flui pelo varistor é predominante mente capacitiva. A Figura 5, mostra a curva tensão x corrente para o mesmo sistema. Neste caso a corrente que flui pelo varistor é tipi camente resistiva, estando em fase com a tensão e dentro da região de ruptura da curva V x I. O sistema 4, apresentou comportamento semelhante ao do sistema 1, tanto para a re gião de baixa tensão como de alta tensão como pode ser observado nas Figuras 6 e 7.

CONCLUSÕES

O efeito de 0.005 mol% de alumina nas características elétricas dos sistemas ZnO. Bi₂O₃.Co₃O₄ e ZnO.Bi₂O₃.Co₃.MnO₂ foi diferente para cada sistema. Observou-se no $\,$ sistema ZnO.Bi_O_3.Co_3O4 um excesso de ions de Al ^{3+}que inibiu o crescimento de grão, causando aumento da condutividade nos contornos de grãos e consequentemente causando a queda nas caracte risticas elétricas. No sistema ZnO.Bi203.00304. MnO₂ a alumina melhorou consideravelmente 0 comportamento não-ôhmico devido provavelmente ao aumento da resistividade dos contornos de grãos, pelas cargas doadoras de elétrons for necidas pela alumina (Al³⁺) absorvidas pelo óxido de manganês. As fases detetadas através de difratometria de raios-X foram ZnO e β.Bi₂O₃, as quais se apresentam distribuidas homogenemante.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq e RHAE pela concessão do Auxílio de Pesquisa e Bolsas de Estudos que viabilizaram o desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

[1] L.M. Levinson, M.R.Philipp. "The Properties of Metal-Oxide Varistors". J.Appl.Phys., V. 47, 1976, pp. 1117. [2] M.Matsouka, "Nonohmic Properties of Zinc Oxides Ceramics". Jpn.J. Appl.Phys., V.10 [6], 1971, pp. 736-746.

- [3] J. Wong and W. G. Morris."Microstructure and Phases in Nonohmic ZnO-Bi₂O₃ Ceramics". <u>Am.Ceram.Soc.Bull</u>., V.53[11],1974, pp.816-820.
- [4] L.M. Levinson and H.R. Philipp. "Zinc Oxide Varistors - A Review". <u>Am.Ceram.Soc.Bull.</u>, v.65[4], 1986, pp. 639-646.
- Viliscia J Active Marcelan. 500. Bull.
 V.65[4], 1986, pp. 639-646.
 [5] Hu Shouxiang, W. Shiliang, Yu Yuchum and Li Singgião. "Effect of Aluminium Doping on the Eletrical Properties of ZnO Varistors".
- [6] Y.L. Tsai, C.L.Huang, C.C. Wei. "Improvement of Nonlinearity in a ZnO Varistor by Al₂O₃ Doping". J.Mat.Sc.Letter, V.4, 1985, pp. 1305-1307.
- [7] J. M. Drier, J.P. Guertin, T. O. Sokoly and L.B. Hackney. "Effect of Dopant Valen ce State on the Microestructure of Zno Va ristors". Advances in Ceram., Vol.7, ed. by Van E.M. and Heuer, A.H.The Amer.Cer. Soc. Inc. Columbus, Ohio, (1983).
- [8] E. A. Zucherato, E.Longo e J. A. Varela. "Análise Crítica da Influência da Alumina em Varistores". Anais do 339 Congresso Bra sileiro de Cerâmica.V.[1], 1989,pp.13-28.

SUMMARY

The effect of 0.005 mol% alumina addition on the varistor tharacteristics of $2n_0.E_{12}O_1.C_{0.0}O_4$ and $2n_0$. Bi₂O₃.Co₅O₄.MnO₂ systems has been analysed in $1100^{\circ}C$ sintered specimens. The former system showed degradation in the electrical behavior probably related to grain growth inhibition due to excess of $A1^{\circ}^{\circ}$ ions , while the latter had an enhancement on the non-ohmic behavior almost certainly due to an increase in grain boundary resistivity.



FIGURA 1 - Micrografia eletrônica de varredura de amostras do sistema 4 (ZnO.Bi₂O₃. Bi₂O₃.Co₃O₄.MnO₂.Al₂O₃).



FIGURA 2 - Micrografia eletrônica de varredura de amostra do sistema 3 (ZnO.Bi₂O₃. Co₃O₄.MnO₂).



FIGURA 3 - Campo claro de amostra do sistema 3 (ZnO.Bi₂O₃.Co₃O₄.MnO₄) apresentando espessa fase intergranular.



FIGURA 4 - Corrente capacitiva que flui no sis tema 1, no início da região de ruptura.



FIGURA 5 - Corrente resistiva no sistema 1,em fase com a tensão, dentro da região de ruptura.



FIGURA 6 - Corrente capacitiva que flui no sis tema 4, no início da região de ruptura.



FIGURA 7 - Corrente resistiva em fase com a tensão, dentro da região de ruptura. Sistema 4.